

記 号 表

A	ソリトンの振幅	[V]
a	可変容量ダイオードの $V_0 - 1/C$ ( $V_0$ ) 特性における係数	
b	可変容量ダイオードの $V_0 - 1/C$ ( $V_0$ ) 特性における係数	
C (V)	キャパシタンス	[F]
F ( $V_0$ )	可変容量ダイオードの特性電圧	[V]
$F_n$	戸田格子における n 番目のばねに働く力	[N]
f	周波数	[Hz]
$f_c$	遮断周波数	[Hz]
$f_i$	入力周波数	[Hz]
I	電流	[A]
$I_n$	n 番目と n + 1 番目にキャパシタを結ぶインダクタに流れる電流	[A]
k	波数	[1/m]
L	インダクタンス	[H]
m	戸田格子におけるばねの質量	[kg]
n	はしご形回路の段数	
Q ( $V_0$ )	可変容量ダイオードに蓄えられる電荷	[C]
$Q_n$	n 番目のキャパシタに蓄えられる電荷	[C]
T	ソリトン幅 (時間)	[sec]
t	時間	[sec]
V	電圧	[V]
$V_i$	入力電圧	[V]
$V_n$	n 番目のキャパシタに加わる電圧	[V]
$V_{n_i}$	インダクタが不純物のときその直前のキャパシタにかかる電圧	[V]
$V_{n_i-1}$	$V_{n_i}$ の前段のキャパシタにかかる電圧	[V]
$V_{n_i+1}$	インダクタが不純物のときその直後のキャパシタにかかる電圧	[V]
$V_{n_i+2}$	$V_{n_i+1}$ の後段のキャパシタにかかる電圧	[V]
$V_0$	ダイオードの逆バイアス電圧	[V]
$v$	ソリトンの速度	[m/sec]
$\omega$	角周波数	[1/sec]
$\omega_c$	遮断角周波数	[1/sec]
$\lambda$	波長	[m]